

電気泳動による球体への酸化物被覆と 強誘電体配向膜の作製

法政大学 生命科学部 環境応用化学科 教授 明石孝也

令和7年7月10日





本技術に関する知的財産権

• 発明の名称:セラミックスコンポジット膜の形成方法

• 出願番号 :特願2022-208613

: 法政大学 出願人

• 発明者 :明石孝也



一 優先権主張出願

「ナノ粒子分散コートによる合金の耐熱性・摺動性の向上」

令和4年に発表済み

発明の名称:セラミックコンポジット膜の形成方法

出願番号:特願2021-212652

出願人:学校法人法政大学

発明者 :明石孝也



新技術説明会 New Technology Presentation Meetings!

2つの課題(コンポジット膜作製)

■厚い粒子堆積層の形成

軸受け(ベアリング)

エネルギー消費量 低減 機械の高寿命化



→ 摩擦を低減させることが必要

YPSZとCeO2を堆積させた軸受け鋼球



低摩擦係数 (高摺動性) 高耐摩耗性



法政大学 令和4年に発表済み

◎薄い配向膜の低温合成

BaTi₂O₅-BaTiO₃ 強誘電体 (骨格粒子配向薄膜)

基盤研究(C)

BaTi₂O₅強誘電体の発見

明石ら(2003年1月原稿受領) 秋重ら(2003年3月原稿受領)

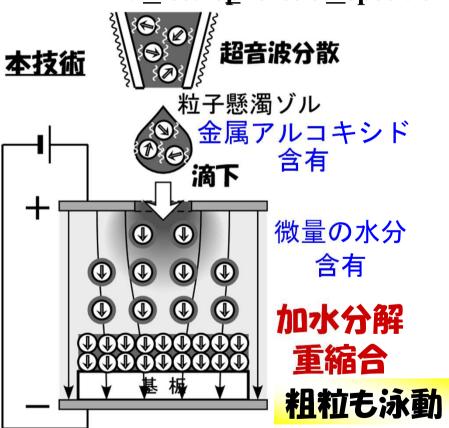
- **○高いキュリー点(475°C)**
- ×b軸方向のみの強誘電性
- ×準安定相(1220-1230℃で安定)



2つの課題(コンポジット膜作製)

■厚い粒子堆積層の形成 ゾル<u>滴下EPD法</u>

EPD: Electrophoresis Deposition



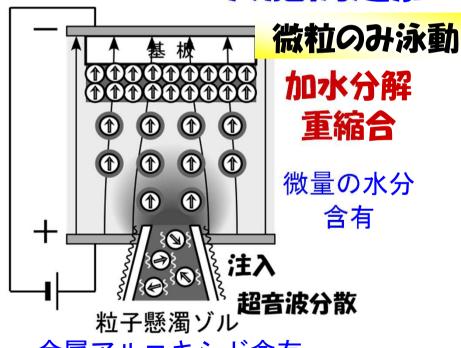
アルコール中での化学反応

法政大学 令和4年に発表済み

●薄い配向膜の低温合成 ゾル注入EPD法

EPD: <u>Electrophoresis</u> <u>Deposition</u>

<u>本技術(改良型)</u> 実施例追加



金属アルコキシド含有

アルコール中での化学反応



BaTi₂O₅強誘電体発見の流れ

ScopusI=T2025/6/10

- "The phase diagram of the BaO-TiO₂ system", W.O. Statton, J. Chem. Phys. 19, 33-40 (1951). 融液からの針状結晶成長
- "Synthesis and characterization of BaTi₂O₅", G. Pfaff, J. Mater. Sci. Lett., 9, 1145-1147 (1990).
 溶液からの単相合成
- "Preparation of BaTi₂O₅ single crystal by a floating zone method", <u>T. Akashi</u>,
 H. Iwata, <u>T. Goto</u>, *Mater. Trans*, 44, 802-804 (2003).
 2003年1月原稿受領、4月発行
 誘電率ピークの異方性発表
 被引用
- *"New ferroelectric barium titanate, BaTi₂O₅", <u>Y. Akishige</u>, K. Fukano, H. Shigematsu, *Jpn. J. Appl. Phys*, 42 (2003). ヒステリシスループ発表 2003年3月原稿受領、8月発行 被引用
- ""Dielectric property of Single Crystalline BaTi₂O₅ prepared by a floating zone method", <u>T. Akashi</u>, H. Iwata, <u>T. Goto</u>, *Mater. Trans*, 44, 1644-1646 (2003). 2003年4月原稿受領、8月発行 レステリシスループの異方性発表 70
- "A ferroelectric barium titanate, BaTi₂O₅", T. Kimura, <u>T. Goto</u>, H. Yamane, H. Iwata, T. Kajiwara, <u>T. Akashi</u>. *Acta Cryst. C*59 128-130 (2003).



異動によりBaTi205研究から離脱

洁晶構造修正 Scopus(6/1



BaTi₂O₅強誘電体と薄膜作製時の課題

◎薄い配向膜の低温合成

BaTi₂O₅強誘電体の発見 **以** 明石ら、秋重ら(2003年)

- ○高いキュリー点(475℃)
- ×b軸方向のみの強誘電性
 - □⇒ b軸配向が必要
- ×**準安定相** (1220-1230℃で安定)

BaTi₂O₅のb軸配向膜作製パルスレーザー蒸着(MgO基板上) C. Wang, R. Tu, <u>T. Goto</u> (2007年)

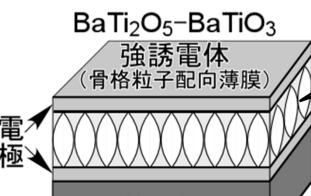


2016年~ ソルゲル被覆

2018年~ 電気泳動堆積(EPD)

2019年~ ゾル滴下EPD

2022年~ ゾル注入EPD



コンポジット膜

基 板





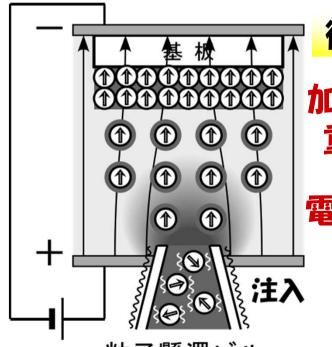
研究目的1 (薄い配向膜の低温合成)

ゾル<u>注入</u>電気泳動堆積(EPD)法により、 BT2微粒子からなるBT2-BTコンポジット

強誘電体薄膜を作製する。

BT2: BaTi₂O₅

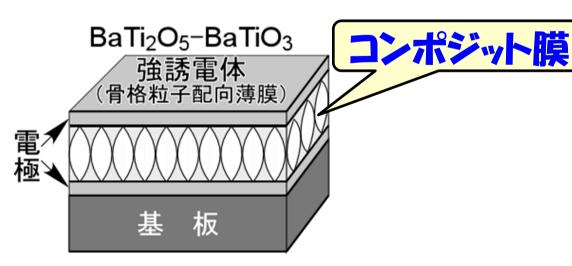
BT: BaTiO₃



微粒のみ泳動

加水分解 重縮合

電気泳動



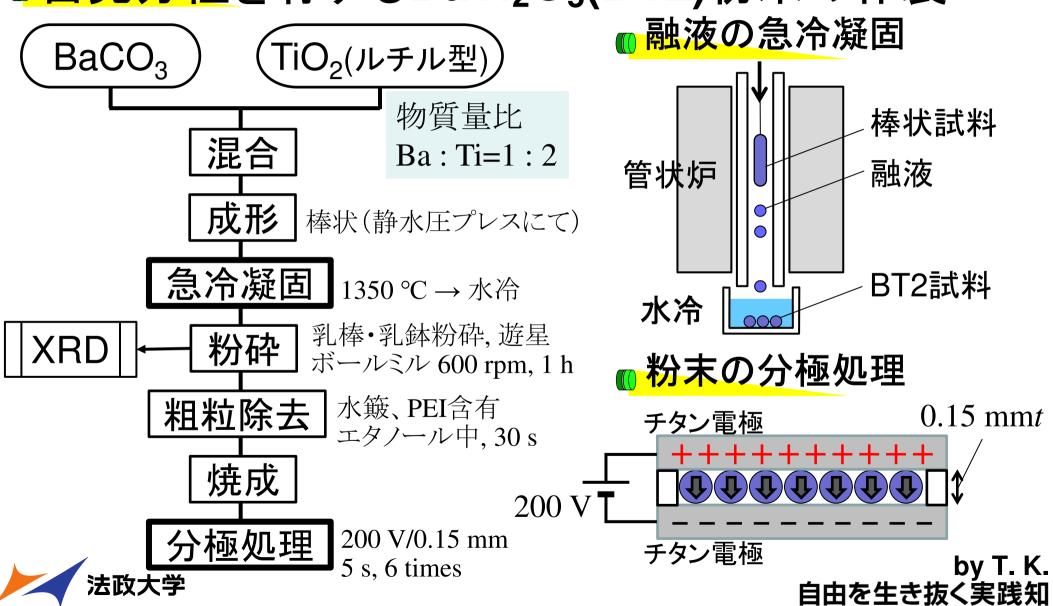
粒子懸濁ゾル

法政大学



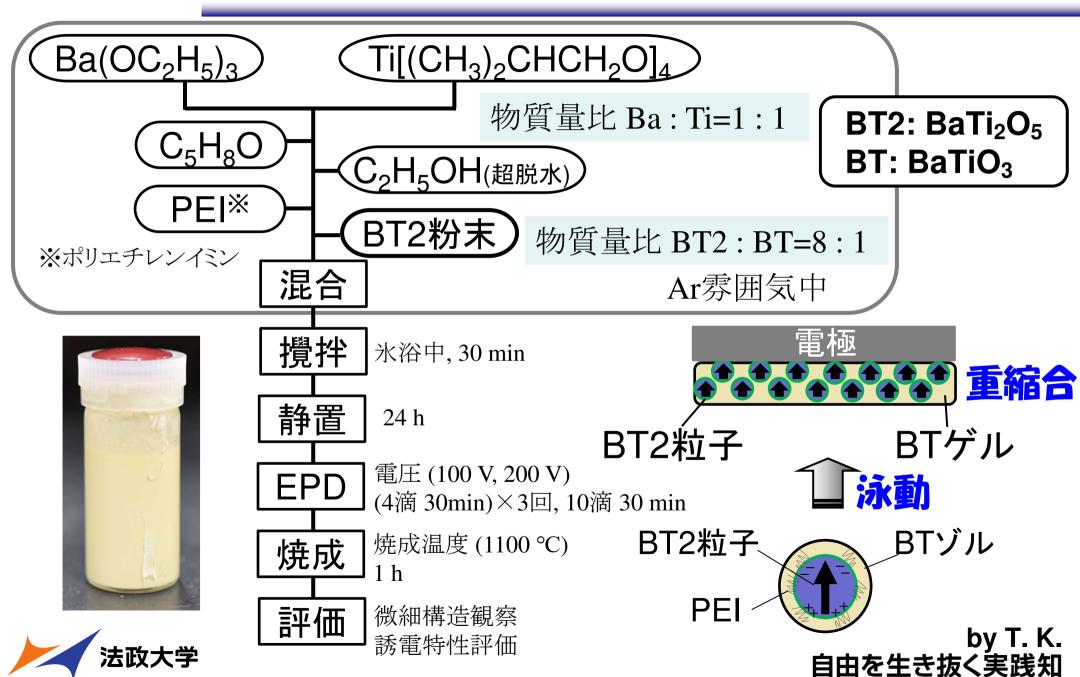
BT2粉末作製と分極処理

■自発分極を有するBaTi₂O₅(BT2)粉末の作製



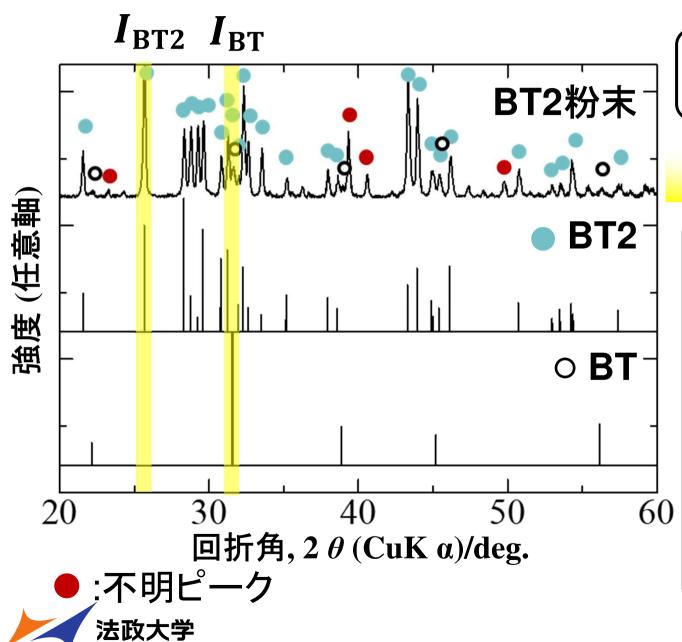
新技術説明会 New Technology Presentation Meetings!

ゾル注入EPD法によるBT2-BT薄膜の作製





BT2粉末のXRD図とBT2生成率



BT2: BaTi₂O₅

BT: BaTiO₃

BT2生成率, α=0.8

BT2生成率※

$$\alpha = \frac{I_{\text{BT2}}}{(I_{\text{BT2}} + I_{\text{BT}})}$$

 $I_{\rm BT2}$: $2\theta = 25.6^{\circ}$

 $I_{\rm BT}$: 2θ =31.7°

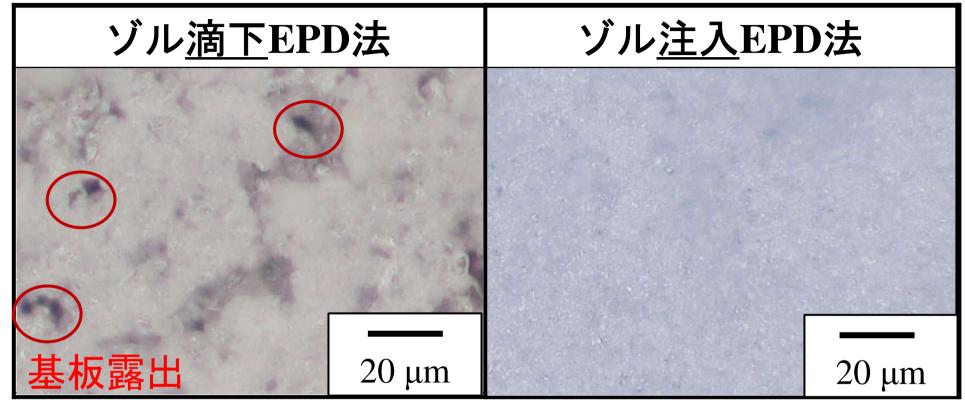
※ N. Zhu, A.R. West.,

J. Am. Ceram. Soc. (1993)

by T. K. 自由を生き抜く実践知



BT-BT2コンポジット膜の光学顕微鏡像



EPD電圧100 V、1100 °C×1 h焼成

EPD電圧200 V、1100 °C×1 h焼成

- ・亀裂や穴が多い
- ▪膜厚は<mark>約30 μm</mark>

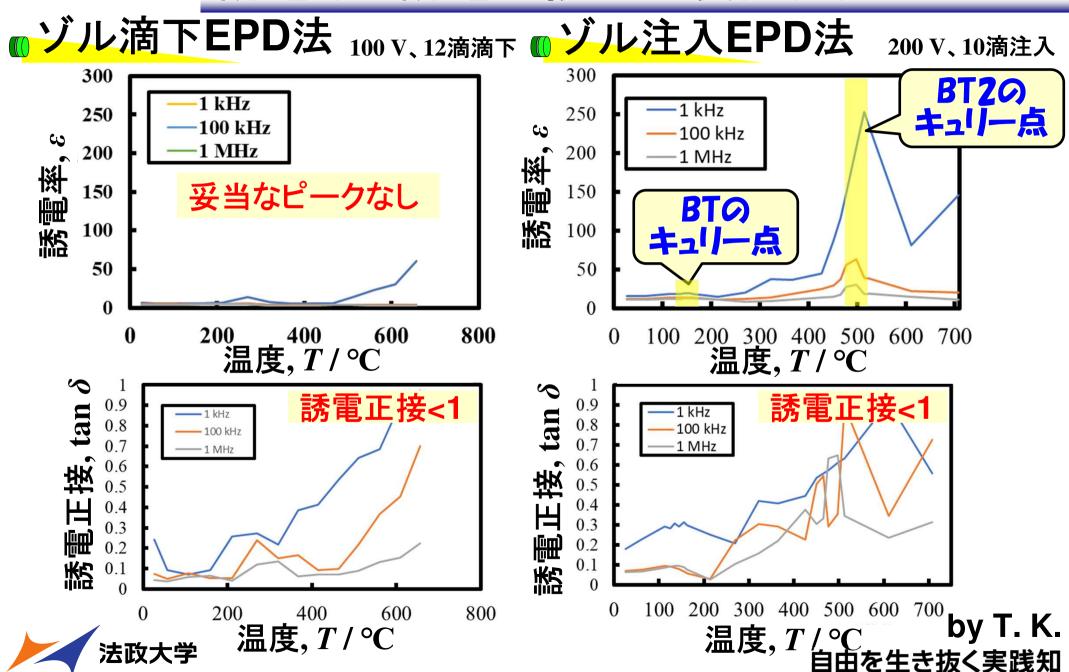
- ・膜厚は<mark>約20 μm</mark>



by T. K. 自由を生き抜く実践知

新技術説明会 New Technology Presentation Meetings!

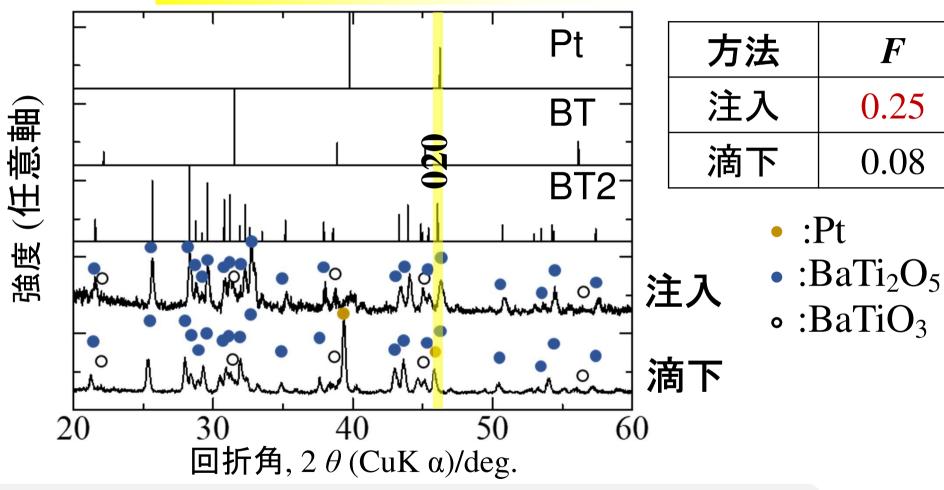
誘電率と誘電正接の温度依存性





Lotgering因子によるb軸配向性評価

BT2のb軸配向度, F=0.25



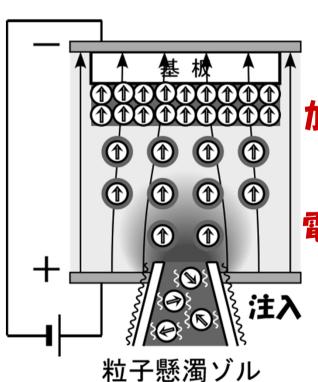
Lotgering因子
$$F = \frac{(P - P_0)}{(1 - P_0)}$$
 無配向 $P_0 = \frac{\sum I_0(0 \ k \ 0)}{\sum I_0(h \ k \ l)}$ 配向 $P = \frac{\sum I \ (0 \ k \ 0)}{\sum I \ (h \ k \ l)}$

by T. K.



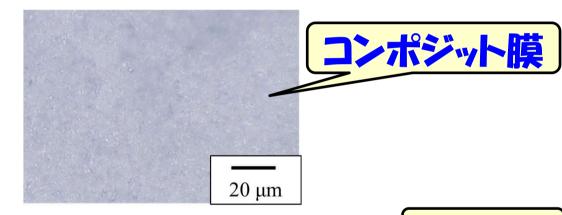
まとめ1 (薄い配向膜の低温合成)

ゾル<u>注入</u>電気泳動堆積(EPD)法により、 BT2-BTコンポジット強誘電体薄膜を作製した。



加水分解 重縮合

電気泳動



BT2: BaTi₂O₅, BT: BaTiO₃

- ⋒当時(2022年度末)の課題
 - -BT2粉末の生成率向上 ⇒ α=1達成
- ・膜の高密度化
- ·BT2のb軸配向度向上

⇒ 試行錯誤中

再現実験中



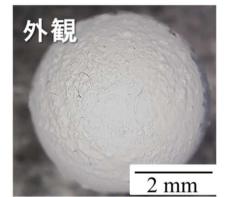


研究目的2(厚い粒子堆積層の形成)

ゾル滴下電気泳動堆積(EPD)法により、 軸受け鋼球に高摺動性のCeO2-YPSZ

コンポジットを被覆する。「YPSZ: Y2O3部分安定化ZrO2

YPSZとCeO₂を堆積させた軸受け鋼球

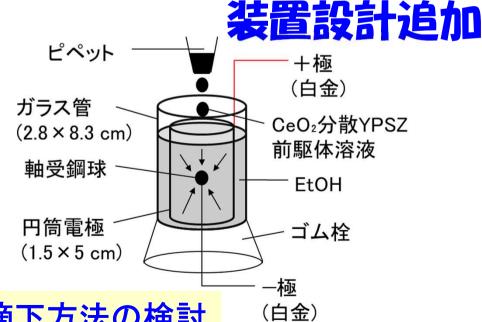


低摩擦係数 (高摺動性) 高耐摩耗性



令和4年に発表済み

『ゾル滴下EPD法 (円筒電極)



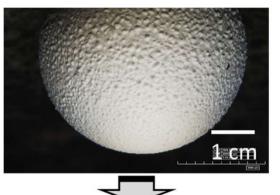




新技術説明会

ゾル滴下EPD後試料の側面からの観察



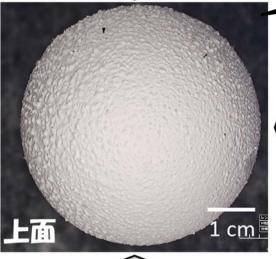


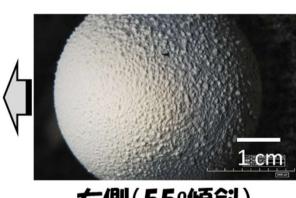
8滴滴下 / 日×3日

球全面へのコーティングが なされた。



左側(55°傾斜)





右側(55°傾斜)





角度可変ロータリーヘッド使用

by S. N. 自由を生き抜く実践知





まとめ2 (厚い粒子堆積層の形成)



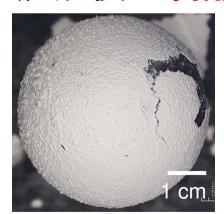
円筒電極を用いたゾル<u>滴下</u>電気泳動堆積 (EPD)法により、軸受け鋼球にCeO₂-YPSZコンポジットを被覆した。

■ゾル滴下EPD法 (円筒電極)

YPSZ: Y₂O₃部分安定化ZrO₂

◎当時(2022年度末)の課題

焼成後の剥離 (全面被覆時)



Ar-5 %H₂中昇温 50 °C/h 大気中焼成 700°C, 1 h



試行錯誤中



従来技術とその問題点

■BaTi₂O₅のb軸配向膜作製に関して

競合する技術としてパルスレーザー蒸着によるMgO基板上へのエピタキシャル成長がある。

しかし、強誘電体薄膜として用いるためには、 金属電極上への配向膜作製が望ましい。

本技術は、金属電極上への強誘電体配向膜を形成させるポテンシャルを有する。

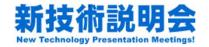




新技術の特徴・従来技術との比較

- ■BaTi₂O₅のb軸配向膜作製に関して
- 急冷凝固法により、単相の準安定相BaTi₂O₅
 粉末の作製に成功している。
- BaTi₂O₅粉末を用いたゾル注入電気泳動堆 積法により、Pt電極膜上にBaTi₂O₅-BaTiO₃ コンポジット強誘電体薄膜を作製した。
- 従来技術では、金属電極上へのBaTi₂O₅のb 軸配向膜成長は困難であろう。





想定される用途

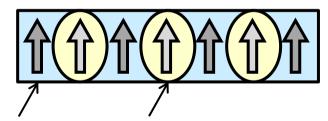
■BaTi₂O₅のb軸配向膜作製に関して

- 鉛フリー高温用強誘電体薄膜
 - → 高温用強誘電体メモリ

AI作動危機等に搭載か?

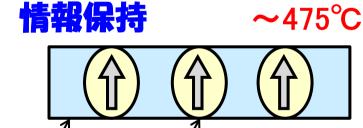
情報記錄

自発分極



BaTiO₃ BaTi₂O₅ コンポジット膜 法政大学





BaTiO₃ BaTi₂O₅ コンポジット膜



実用化に向けた課題

- ■BaTi₂O₅のb軸配向膜作製に関して
- BaTi₂O₅単相合成の再現性確認
 - → 単相合成条件の更なる最適化を行う。
- BaTi₂O₅-BaTiO₃コンポジット薄膜の高密度化
 - → 電気泳動と焼成の条件を再検討する。
- BaTi₂O₅のb軸配向性の向上
 - → 分散剤の種類を再検討する。

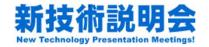




社会実装への道筋

時期	取り組む課題や明らかにしたい原理等	社会実装へ取り組みについて記載
基礎研究	•BaTi ₂ O ₅ の単相合成に成功(再現性を 確認中)	
現在	•BaTi₂O₅-BaTiO₃コンポジット強誘電体を作製(BaTi₂O₅のb軸配向性向上と膜の高密度化に向けて研究中)	
5年後	・高温用強誘電体メモリへの応用	JSTのA-STEP産学共同ステージI (育成フェーズ)に応募し研究資金獲 得
10年後	-BaTi ₂ O ₅ -BaTiO ₃ コンポジット強誘電体の特性評価(誘電率、誘電正接、 <i>D-E</i> ヒステリシスループ)	サンプル提供の実現





企業への期待

- ■BaTi₂O₅のb軸配向膜作製に関して
- 今後、鉛フリー高温用強誘電体のニーズが高まる可能性があれば、その情報を頂きたい。
- ∞本特許技術全体について
- AI作動危機等に搭載か?
- ・金属表面への酸化物粒子堆積層の形成を検討している企業の方と、ゾル滴下EPD法およびゾル注入EPD法の適用可能性を共同で検討したい。





企業への貢献、PRポイント

- ■BaTi₂O₅のb軸配向膜作製に関して
- AI作動機器等の異常発熱が生じる機器の強 誘電体メモリとして応用できる可能性がある。
- BaTi₂O₅は、鉛フリーの高温用強誘電体として、日本※で発見された強誘電体である。
 - ※ 2グループから発表
- 本発表者は、最初に発表されたBaTi₂O₅強誘 電体の論文の第一著者である。





本技術に関する知的財産権

発明の名称:セラミックスコンポジット膜の形成 方法

● 出願番号:特願2022-208613

• 出願人 : 法政大学

• 発明者 :明石孝也



優先権主張出願

• 発明の名称:セラミックコンポジット膜の形成方法

• 出願番号:特願2021-212652

• 出願人:学校法人法政大学

発明者 : 明石孝也



法政大学



産学連携の経歴

本技術に関する産学連携の経歴はない。

(参考) ガリウムのリサイクルに関する産学連携の経歴

- 2011年 JST A-STEP FSステージ探索タイプに採択
- 2013年 JST知財活用促進ハイウェイに採択
- 2015年-2016年 環境省 環境研究総合推進費補助金に採択
- 産学連携によるLED照明リサイクルスキームの事業化
- 2019年 ハリタ金属(株)と共同研究実施(環境省省CO2型リサイクル等設備技術実証事業、研究分担)





お問い合わせ先

法政大学 研究開発センター リエゾンオフィス

TEL 042-387-6501

FAX 042 - 387 - 6335

e-mail liaison@ml.hosei.ac.jp

